

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/010500

International filing date: 08 June 2005 (08.06.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-215239
Filing date: 23 July 2004 (23.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 22 July 2005 (22.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 7月 23日

出願番号 Application Number: 特願2004-215239

パリ条約による外国への出願に用いる優先権の主張の基礎となる出願の国コードと出願番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

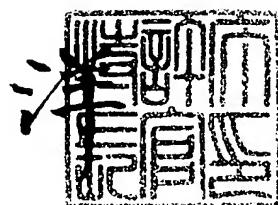
J P 2004-215239

出願人 Applicant(s): 松下電器産業株式会社

2005年 7月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 2048260012
【提出日】 平成16年 7月23日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G06T 15/40
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
【氏名】 若山 順彦
【特許出願人】
【識別番号】 000005821
【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100097445
【弁理士】
【氏名又は名称】 岩橋 文雄
【選任した代理人】
【識別番号】 100103355
【弁理士】
【氏名又は名称】 坂口 智康
【選任した代理人】
【識別番号】 100109667
【弁理士】
【氏名又は名称】 内藤 浩樹
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 011305
【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9809938

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

隠れ面除去法として乙バッファ法を使う、3次元形状を表示する3次元形状描画装置において、

形状を描画する描画部と、

前記描画部で描画された画素データを保存する画像メモリと、

前記描画部で描画された各画素の奥行き値の上位ビットを保存する描画部から高速にアクセスできる上位乙バッファメモリと、

前記描画部で描画された各画素の奥行き値の下位ビットを保存する描画部から低速にアクセスできる下位乙バッファメモリと、

前記描画部で描画している画素の奥行きとの上位ビットとその位置に以前前記上位乙バッファメモリに書かれていた画素の奥行き値の上位ビットを比較する上位乙バッファ比較部と、

前記描画部で描画している画素の奥行きとの下位ビットとその位置に以前前記下位乙バッファメモリに書かれていた画素の奥行き値の下位ビットを比較する下位乙バッファ比較部とをもち、

まず、描画を始める前に前記上位乙バッファメモリと前記下位乙バッファメモリに初期値をいれ、形状を描画する際に、描画部により計算された各画素の隠れ面除去を行う際に、奥行き値の上位ビットを前記上位乙バッファメモリに以前書かれた値と比較し、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値がより近ければ前記画像メモリに画素値を、前記上位乙バッファメモリに新たな奥行き値の上位ビットを、前記下位乙バッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込み、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値がより遠ければそのまま次の処理に移り、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値が同じであれば、奥行き値の下位ビットを前記下位乙バッファメモリに以前書かれた値と前記下位乙バッファ比較部で比較し、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値がより近ければ前記画像メモリに画素値を、前記下位乙バッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込み、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値がより遠ければそのまま次の処理に移り、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値が同じであればそのまま次の処理に移る3次元形状描画装置。

【請求項2】

請求項1に記載の3次元形状描画装置において、

書こうとしている画素の奥行き値の上位ビットの値が同じで、奥行き値の下位ビットを前記下位乙バッファメモリに以前書かれた値と前記下位乙バッファ比較部で比較し、

書こうとしている画素の奥行き値の下位ビットの値が同じであれば前記画像メモリに画素値を、前記下位乙バッファメモリに新たな奥行き値の下位ビットをそれぞれ書き込む3次元形状描画装置。

【請求項3】

隠れ面除去法として乙バッファ法を使う、3次元形状を表示する3次元形状描画方法において、

フレームごとに、

画素を保持するフレームメモリを消去するステップと、

奥行き値の上位ビットを保持する上位乙バッファメモリを消去するステップと、

奥行き値の下位ビットを保持する下位乙バッファメモリを消去するステップと、

形状データをもとに描画データを作成するステップと、

作成された描画データの奥行き値の上位ビットを過去に描画された画像の奥行き値の上位ビットと比較するステップと、

前記の上位ビット比較ステップにおいて、新たに描画する画像の上位ビットを過去に描画された画像の奥行き値を比較してより近い場合新たに描画する画像をフレームメモリと上位乙バッファメモリと下位乙バッファメモリに書き込むステップと、

前記の上位ビットを比較するステップにおいて、新たに描画する画像の上位ビットが過去に描画された画像の奥行き値と同じ場合には新たに描画する画像の下位ビットと過去に描画された画像の奥行き値と比較してより近い場合新たに描画する画像をフレームメモリと上位乙バッファメモリと下位乙バッファメモリに書き込むステップとによる3次元形状描画方法。

【請求項4】

請求項3に記載の3次元形状描画方法において、

上位ビット比較ステップにおいて新たに描画する画像の奥行き値の上位ビットが上位乙バッファメモリに入っている過去に描画された画像の奥行き値と同じときかつ下位の奥行き値が下位乙バッファメモリに入っている過去に描画された画像の奥行き値と同じとき新たに描画する画像をフレームメモリと上位乙バッファメモリと下位乙バッファメモリに書き込むステップを持つ3次元形状描画方法。

【請求項5】

請求項1または請求項2に記載の3次元形状描画装置において、画像の奥行き値を必ず上位乙バッファメモリの値が全ビット0にならないようにし、

乙バッファのクリアにおいて、上位乙バッファメモリのみのクリアにした、

3次元形状描画装置。

【請求項6】

請求項3または請求項4に記載の3次元形状描画方法において、上位乙バッファメモリに書き込む画像の奥行き値が必ず全ビット0にならないようにし、下位乙バッファメモリのクリアのステップを省いた、

3次元形状描画方法。

【請求項7】

請求項1、請求項2または請求項5に記載の3次元形状表示装置において、形状を描画する描画部を、奥行き値計算部と、輝度・マテリアル値計算部に分け、

まず、前記奥行き値計算部により奥行き値を計算し、先に奥行き値による描画判定を行い、前記フレームバッファに新たな値を書き込まなければならないときのみ、輝度・マテリアル値計算部により値を計算する、

3次元形状描画装置。

【請求項8】

請求項1、請求項2または請求項5に記載の3次元形状描画装置において、

描画部を二段に分け、早期隠れ面除去描画部と、晚期隠れ面除去描画部とにわけ、

早期隠れ面除去描画部においては、画素の生成と上位乙バッファメモリとの比較を行い、フレームバッファや乙バッファに書き込むべき画素か、書かなくてもよい画素か、下位乙バッファメモリとの比較を行う画素かのフラグをつけて、晚期隠れ面除去処理部に送り、晚期隠れ面除去部では、下位乙バッファメモリとの比較を行う画素であるというフラグがついていた場合、下位乙バッファメモリと比較し、書き込むべき画素である場合と、前記早期隠れ面除去描画部から書き込むべき画素であるというフラグがついていた場合、当該画素をフレームバッファメモリと上位乙バッファメモリと、下位乙バッファに書き込む3次元形状描画装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】3次元形状描画方法ならびに装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、視点からの奥行き値を用いたZバッファ法を隠れ面除去法として使う3次元形状表示装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来の3次元形状表示装置としては、隠れ面除去方式として、Zバッファ法が以前から使われておらず、Zバッファ法を高速化する技術として、画素ごとに1ビットのフラグメモリを持つ方法（たとえば特許文献1）や、複数の画素の一一番遠い奥行き値と一番近い奥行き値を持つ縮退したZバッファを持つ方法（たとえば特許文献2）などがあった。図2、図3は特許文献2に示された従来のZバッファアクセス低減法を示したものである。

【0003】

図2において、画面201は画面の構成をM×Nの領域に分割したものである。ブロック202は画面201のK×Lのピクセルで構成されるひとつのブロックである。MAXZ203は各々のブロック202における最大のZ値を保持するメモリで、すべてのブロックにひとつずつ存在する。MINZ204は各々のブロック202における最小のZ値を保持するメモリで、すべてのブロックにひとつずつ存在する。また、図3において、画像供給部301はポリゴンのデータを画像合成部302に供給し、画像合成部302は、ポリゴンデータをピクセルデータに変換するピクセル描画部303、ピクセルデータの奥行き値とMAXZ203とMINZ204をもつZRバッファ305と、すべてのZ値をもつZメインバッファ306により描画すべきピクセルかどうかを判断する描画判断部304と、描画判断部304により描画すべきピクセルを保持するフレームバッファ307と、フレームバッファ307の画素データを実際の輝度データに変換するパレット回路308からなり、パレット回路308の出力をディスプレイ309に画像を供給する。

【0004】

この方式では、新たに描画する際に、画面201におけるブロック202のMAXZ203、MINZ204と、これから描画しようとする画素のZ値とを比較し、新たなZ値がMAXZ203より大きかった場合、描画を取りやめ、MINZ204より小さかった場合、Zメインバッファ306に新たなZ値を、フレームバッファ307に新たなピクセル値を保存し、MINZ204を新たなZ値により置き換え、これから描画しようとする画素のZ値がMINZ204とMAXZ203の間なら、Zメインバッファ306に入っている当該位置のピクセルのZ値と比較し、これから描画しようとしている画素のZ値の方が小さければ新たなZ値に置き換え、当該ブロック202に属するすべてのZ値をZメインバッファ306を調べ、その中で一番大きなZをMAXZ203の値とする。

【0005】

このようにして、Zメインバッファ306へのアクセスをブロック202単位のZMAX203、ZMIN204の間のときのみにすることにより、アクセス量を低減することができる。

【特許文献1】特開昭62-42281号公報

【特許文献2】特開平8-161526号公報（第5—7頁、図1、図4）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、このような3次元形状描画装置では、ピクセルごとにZメインバッファを読み出す必要をなくすことができるようにならなかったが、MAXZのアップデートのために、ブロックのZすべてを読み出し、比較し最大値を出す必要がある。また、MAXZの計算をしている最中は次のピクセルの処理ができないため、処理が止まってしまう。また、MAXZ、MINZのために余計なメモリを持つ必要がある。また、Zメインバッファのクリ

アとMAXZ、MINZのメモリのクリアが毎回必要となる。

【0007】

本発明はこのような課題を解決するものであり、古典的な乙バッファ方と同じメモリ容量で、描画する物体と以前描画されていた物体の距離が遠い場合は隠れ面除去の速度が速く、近い場合は隠れ面除去の速度が遅く処理され、また、乙バッファクリアをメモリの部分的な消去で可能ならしめ、隠れ面除去を行った後の画素のみ描画計算を行うことで、低い演算性能でも多くの描画を行うことができる3次元形状描画装置を提供するものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するために、本発明は、奥行き値を保存する乙バッファを、奥行き値の上位ビット保存する上位乙バッファと、下位ビットを保存する下位乙バッファにわけることにより、新たに描画する物体の上位ビットのみ上位乙バッファを使ってあらかじめ比較することによって、下位乙バッファにアクセスすることなく、大多数の描画を行うことができる。また、本発明は、物体の奥行き値を限ることにより、下位乙バッファをクリアすることなく、上位乙バッファをクリアするだけで乙バッファをクリアすることができる。また、本発明は、奥行き値の上位ビットの比較を描画部から分離することにより、輝度値の計算を描画されている物体より近い物体を描画計算するときのみに限る。

【発明の効果】

【0009】

以上のように本発明では、乙バッファを上位乙バッファと下位乙バッファに分けることで、アクセス量の低減のみならず、上位乙バッファに高速なSRAMメモリやASIC内蔵メモリを使うことができ、より高速な描画を行うことができる。また、上位乙バッファのみのクリアでよいため、メモリアクセス量の低減と高速化をより進めることができる。また、DSPのような演算器で行う場合、上位乙バッファの比較を行ったのち、輝度の計算等を行うため、同一の演算性能でよりたくさんの物体を描画することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0011】

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1における3次元形状描画装置の隠れ面除去装置を説明した図である。

【0012】

図1において、101はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部、102は画像メモリ103に入っている各画素の奥行き値の上位8ビットが入っている上位乙バッファメモリ、103は描画部101で描画され、隠れ面除去された画像が入っている画像メモリ、104は画像メモリ103に入っている各画素の奥行き値の下位16ビットが入っている下位乙バッファメモリ、105は奥行き値の上位8ビットを比較する上位乙バッファ比較部、106は奥行き値の下位16ビットを比較する下位乙バッファ比較部、107はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部101にあって、画素の奥行き値を計算する奥行き値計算部、108はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部101にあってピクセルの明るさである輝度値や表面の質感であるマテリアル値を計算する輝度・マテリアル計算部、109は上位乙バッファメモリ102を初期化する上位乙バッファクリア部、110は下位乙バッファメモリ103を初期化する下位乙バッファクリア部である。

【0013】

図4は図1における上位乙バッファメモリ102、下位乙バッファメモリ104に图形401と图形402の情報を描いた様子を示す。ピクセル403は本実施の形態説明のための、上位乙バッファメモリ102と下位乙バッファメモリ104のある同一座標のピク

セルである。なお、本実施の形態の説明のために画像メモリ103は図4では省いている。

【0014】

かかる構成により、3次元形状データによる画像を生成するためには、まず上位乙バッファクリア部109と下位乙バッファクリア部110で上位乙バッファメモリ102と下位乙バッファメモリ104を初期値つまり、視点から見たときの最遠の値で塗りつぶす。ここでは仮に最遠の値を十六進数で000000Hの24ビットの精度の値とする。図4では、上位乙バッファメモリ102は上位8ビット、下位乙バッファメモリ104は16ビットなので、各々00Hと0000Hで初期化する。なお、専用の上位乙バッファクリア部109や下位乙バッファクリア部110を持たずに描画部101をもちいて最遠値000000Hで値を埋めてもよい。次に、処理すべき3次元形状である、図形401や図形402を描画部101で処理するときに、はじめに3次元形状の各々のピクセルの奥行き値Znowを奥行き値計算部107で計算する。上位乙バッファ比較部105が、計算された奥行き値Znowの上位8ビットZnowHIと、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の上位8ビットZoldHIを上位乙バッファメモリ102から読み出し、ZnowHI > ZoldHIならば、輝度・マテリアル計算部108でピクセルの輝度値等Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値Znowとともに、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ビットZnowHIは上位乙バッファメモリ102に、Znowの下位16ビットZnowLOは下位乙バッファメモリ104に書き込む。

【0015】

$ZnowHI = ZoldHI$ ならば、下位乙バッファ比較部106があらためてZnowの値の下位16ビットZnowLOの値と、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の下位16ビットZoldLOを下位乙バッファメモリ104から読み出し、ZnowLO > ZoldLOならば、輝度・マテリアル計算部108でピクセルの輝度値等Inowを計算し、先ほど計算した奥行き値Znowとともに、Inowは画像メモリ103に書き込み、Znowの上位8ビットZnowHIは上位乙バッファメモリ102に、Znowの下位16ビットZnowLOは下位乙バッファメモリ104に書き込み、 $ZnowLO \leq ZoldLO$ ならば輝度・マテリアル計算部108での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

【0016】

$ZnowHI < ZoldHI$ ならば、輝度・マテリアル計算部108での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

【0017】

ピクセル403を例に挙げると、はじめに上位乙バッファクリア部109と下位乙バッファクリア部110で各々の初期値00H、0000Hで初期化される。次に、図形401を描画する際に図形401のピクセル403の位置の奥行き値の上位8ビットZ401HIを上位乙バッファメモリ102に入っている初期値00Hと比較し、Z401HIの方が大きいため上位乙バッファメモリ102のピクセル403にはZ401HIが書き込まれ、下位乙バッファメモリ104のピクセル403にはZ401LOが書き込まれ、画像メモリ103のピクセル403に輝度値が書き込まれる。次に、図形402を描画する際に図形402のピクセル403の位置の奥行き値の上位8ビットZ402HIを上位乙バッファメモリ102に入っている図形402の奥行き値Z402HIと比較し同じであった場合、図形402のピクセル403の位置の奥行き値の下位16ビットZ402LOを下位乙バッファメモリ104に入っているZ401LOと比較し、Z401HIの方が大きいため上位乙バッファメモリ102や下位乙バッファメモリ104や画像メモリ103にはあらたな書き込みがなく、つぎの図形の処理に移る。

【0018】

なお、本発明では輝度・マテリアル計算部108の計算は奥行き値の比較が終わって必要なときのみ計算するようになっているが、奥行き値計算部107での計算と同時に行っ

てもよい。また、奥行き値計算部107での処理、上位乙バッファ比較部105での処理、下位乙バッファ比較部106での処理、輝度・マテリアル計算部108での処理をバイブライイン的に処理してもよい。

【0019】

なお、ピクセルの奥行き値を24ビットの16進数で010000Hを一番奥にし、3次元形状がそれより近くなるように描画部101へ入る形状データを制御することにより、上位乙バッファクリア部109が上位乙バッファメモリ102を8ビットの16進数で00Hの値でのクリアのみで、下位乙バッファクリア部110による下位乙バッファメモリ104のクリアを省き、メモリアクセス量を減らすことができる。

【0020】

なお、上位乙バッファ比較部105の上位乙バッファメモリ102へのアクセスは、下位乙バッファ比較部106の下位乙バッファメモリ104へのアクセスに比べて頻度が少なくかつ、乙の値のうちの上位8ビットのみでよいため、高速な小容量のメモリを使って、アクセス量の低減以上に高速化してもよい。

【0021】

なお、この実施の形態では一例として上位奥行き値を8ビット、下位奥行き値を16ビットの合計24ビットの精度としたが、合計のビット数ならびに、上位、下位の分け方は任意でよい。

【0022】

(実施の形態2)

図5は、本発明の実施の形態2における3次元形状描画装置の隠れ面除去方法を説明したフローチャートである。図6は、本発明の実施形態2における3次元形状描画装置を説明したものである。

【0023】

図5において、501は上位乙バッファメモリ102と画像メモリ103を初期化する上位乙バッファ・画像メモリクリアステップ、502は下位乙バッファメモリ104を初期化する下位乙バッファクリアステップ、503はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画ステップ、504は描画ステップ503でえられたポリゴンの各ピクセルにおける奥行き値の上位8ビットを比較する上位乙バッファ比較ステップ、505は奥行き値の下位16ビットを比較する下位乙バッファ比較ステップ、506はピクセルデータを上位乙バッファメモリ102、下位乙バッファメモリ104、画像メモリ103に書き込む、描き戻しステップである。

【0024】

図6において、101はポリゴンデータをピクセルデータに変換する描画部。601は奥行き値の上位ビットの1画面分を持っている上位乙バッファメモリ102を記録する高速グラフィックスメモリ、602は奥行き値の下位ビットの1画面分を記録する下位乙バッファメモリ104と画面のピクセルデータを記録する低速グラフィックスメモリである。

【0025】

かかる構成により、3次元形状データによる画像を生成するためには、1画面ごとに、上位乙バッファメモリ102を視点から見た最遠の値で、画像メモリ103を初期値で塗りつぶす上位乙バッファ・画像メモリクリアステップ501を描画部101を使って行い、次に下位乙バッファメモリ104を視点から見た最遠の値で塗りつぶす下位乙バッファメモリクリアステップ502を描画部101を使って行う。

【0026】

次に、3次元形状の各々のピクセルの奥行き値Znowを描画ステップ503で計算し、上位乙バッファ比較ステップ504で計算された奥行き値Znowの上位8ビットZnowHIと、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の上位8ビットZoldHIを上位乙バッファメモリ102から読み出し、ZnowHI > ZoldHIつまり、現在描画しているピクセルのほうが近いのならば、描き戻しステップ5

06に飛びピクセルの輝度値等 I_{now} を計算し、先ほど計算した奥行き値 Z_{now} とともに、 I_{now} は画像メモリ103に書き込み、 Z_{now} の上位8ビット Z_{nowH1} は上位Zバッファメモリ102に、 Z_{now} の下位16ビット Z_{nowL0} は下位Zバッファメモリに書き込む。

【0027】

$Z_{nowH1} = Z_{oldH1}$ ならば、下位Zバッファ比較部106があらためて Z_{now} の値の下位16ビット Z_{nowL0} の値と、そのピクセルの位置に対応するすでに描画されている画像の奥行き値の下位16ビット Z_{oldL0} を下位Zバッファメモリ104から読み出し、 $Z_{nowL0} > Z_{oldL0}$ ならば、描き戻しステップ506でピクセルの輝度値等 I_{now} を計算し、先ほど計算した奥行き値 Z_{now} とともに、 I_{now} は画像メモリ103に書き込み、 Z_{now} の上位8ビット Z_{nowH1} は上位Zバッファメモリ102に、 Z_{now} の下位16ビット Z_{nowL0} は下位Zバッファメモリ104に書き込み、 $Z_{nowL0} \leq Z_{oldL0}$ ならば描き戻しステップ506での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

【0028】

$Z_{nowH1} < Z_{oldH1}$ ならば、下位Zバッファ比較ステップ505と描き戻しステップ506での処理は行わずに次のピクセルの処理を行う。

【0029】

なお、本発明では描き戻しステップ506の計算は奥行き値の比較が終わって必要なときのみ計算するようになっているが、描画ステップ503での計算と同時にあってよい。

【0030】

なお、ピクセルの奥行き値を24ビットの16進数で010000Hを一番奥にし、3次元形状がそれより近くなるように描画ステップ503へ入る形状データを制御することにより、上位Zバッファ・画像メモリクリアステップ501が上位Zバッファメモリ102を8ビットの16進数で00Hの値でのクリアのみで、下位Zバッファクリアステップ502による下位Zバッファメモリ104のクリアを省き、メモリアクセス量や処理量を減らすことができる。

【0031】

なお、上位Zバッファメモリ102へのアクセスは、下位Zバッファメモリ104や画像メモリ103へのアクセスに比べて頻度が多くかつ、Zの値のうちの上位8ビットのみでよいため、高速な小容量の高速グラフィックメモリ601を使い、下位Zバッファメモリ104や画像メモリ103を大容量だが低速な低速グラフィックスメモリ602に割り当て、コストアップを最低限にしつつ、アクセス量を低減し高速化してもよい。

【0032】

なお、この実施の形態では一例として上位奥行き値を8ビット、下位奥行き値を16ビットの合計24ビットの精度としたが、合計のビット数ならびに、上位、下位の分け方は任意でよい。

【産業上の利用可能性】

【0033】

本発明にかかる3次元形状描画装置は、隠れ面除去法としてZバッファ法を用い、奥行き値の上位ビットを先行的に比較することでバスアクセス量を減じ、限られたバス幅でも高速に3次元形状を描画するのに有効である。

【図面の簡単な説明】

【0034】

【図1】本発明の実施の形態1を説明する図

【図2】従来の方法を説明する図

【図3】従来の方法を説明する図

【図4】本発明の実施の形態1を説明する図

【図5】本発明の実施の形態2を説明する流れ図

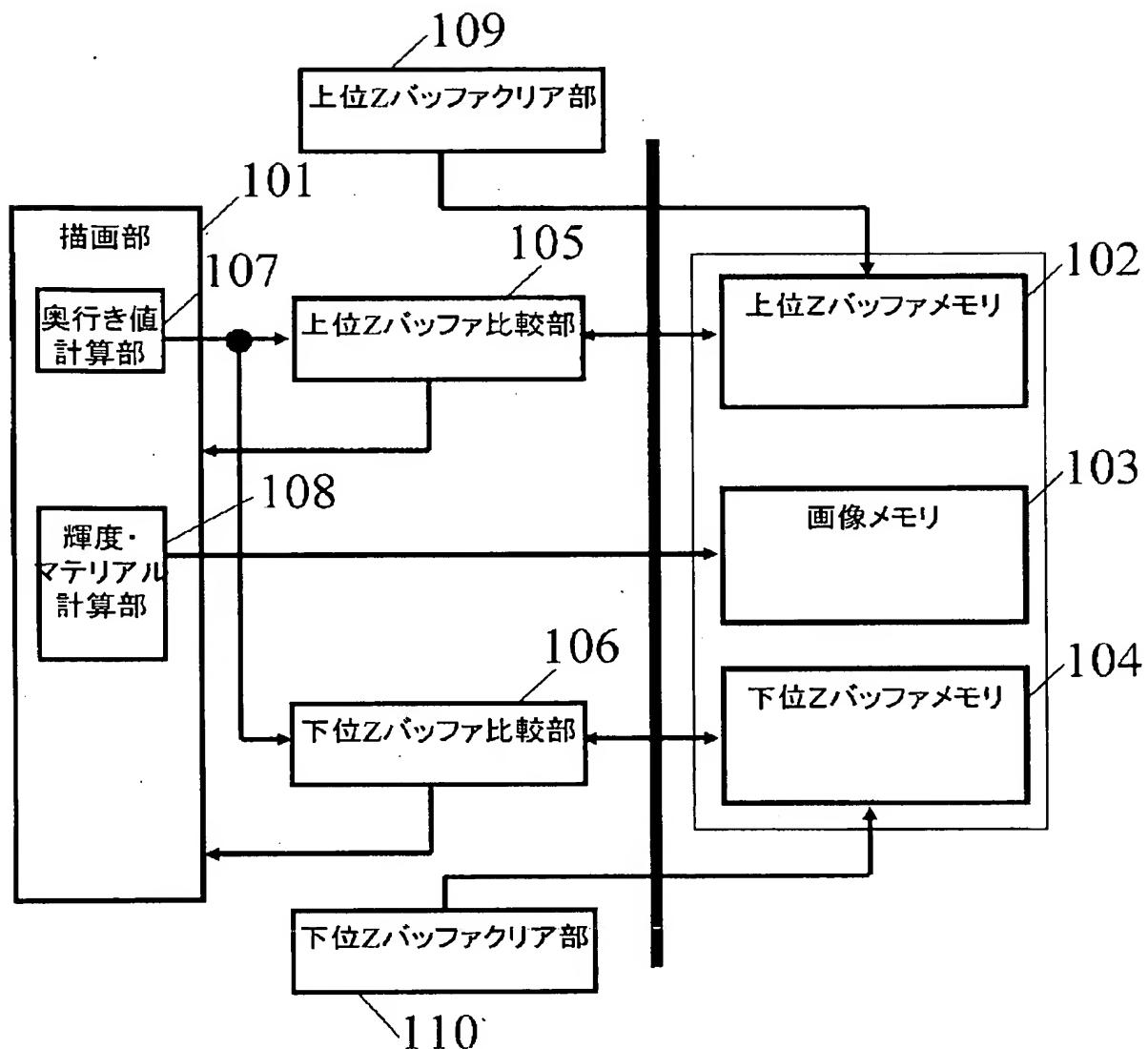
【図6】本発明の実施の形態2を説明する図
【符号の説明】

【0035】

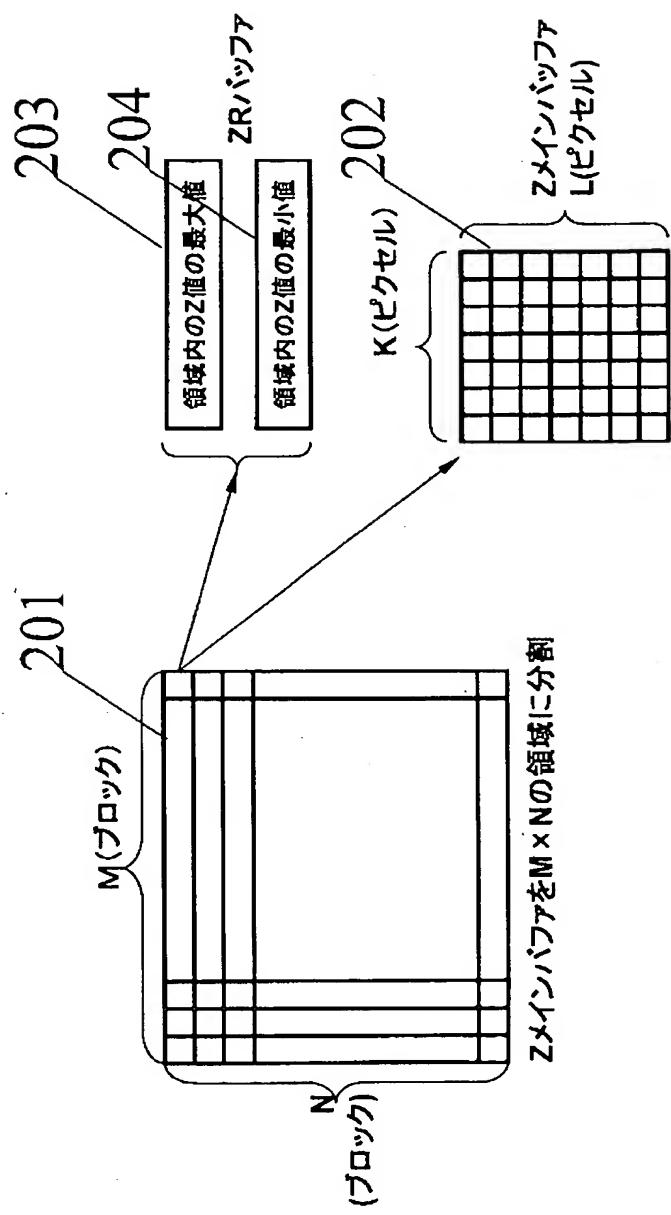
- 101 描画部
- 102 上位Zバッファメモリ
- 103 画像メモリ
- 104 下位Zバッファメモリ
- 105 上位Zバッファ比較部
- 106 下位Zバッファ比較部
- 107 奥行き値計算部
- 108 輝度・マテリアル計算部
- 109 上位Zバッファクリア部
- 110 下位Zバッファクリア部
- 201 M×Nの領域に分割された画面
- 202 画面を分割したブロックの一つ
- 203 ブロック内のZ値の最大値
- 204 ブロック内のZ値の最小値
- 301 画像供給部
- 302 画像合成部
- 304 描画判断部
- 305 ZRバッファ
- 306 Zメインバッファ
- 307 フレームバッファ
- 308 バレット回路
- 309 ディスプレイ
- 310 描画処理部
- 401, 402 図形
- 403 図形を構成する1ピクセル
- 501 上位Zバッファ・画像メモリクリアステップ
- 502 下位Zバッファクリアステップ
- 503 描画ステップ
- 504 上位Zバッファ比較ステップ
- 505 下位Zバッファ比較ステップ
- 506 描き戻しステップ
- 601 高速グラフィックメモリ
- 602 低速グラフィックメモリ

【書類名】 図面

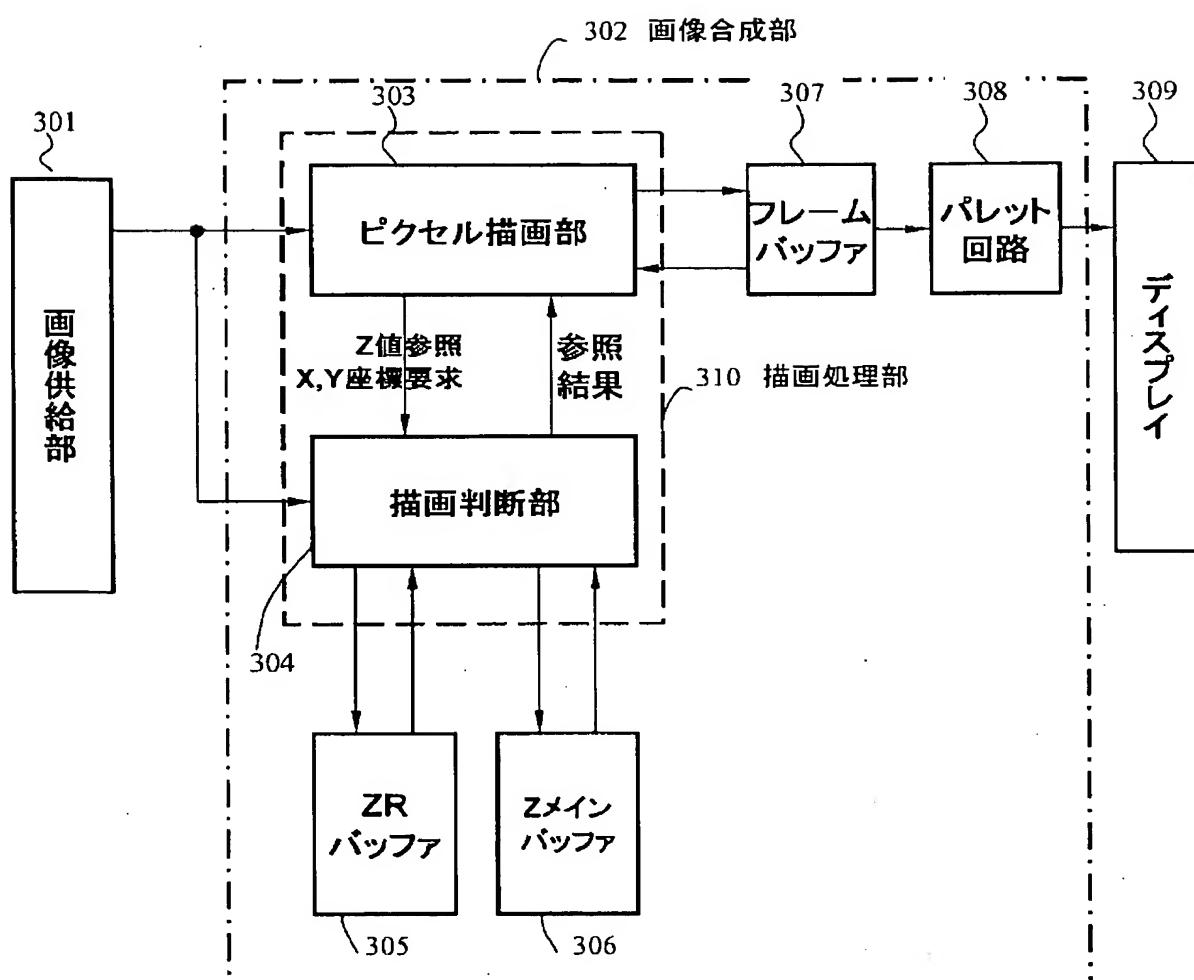
【図 1】



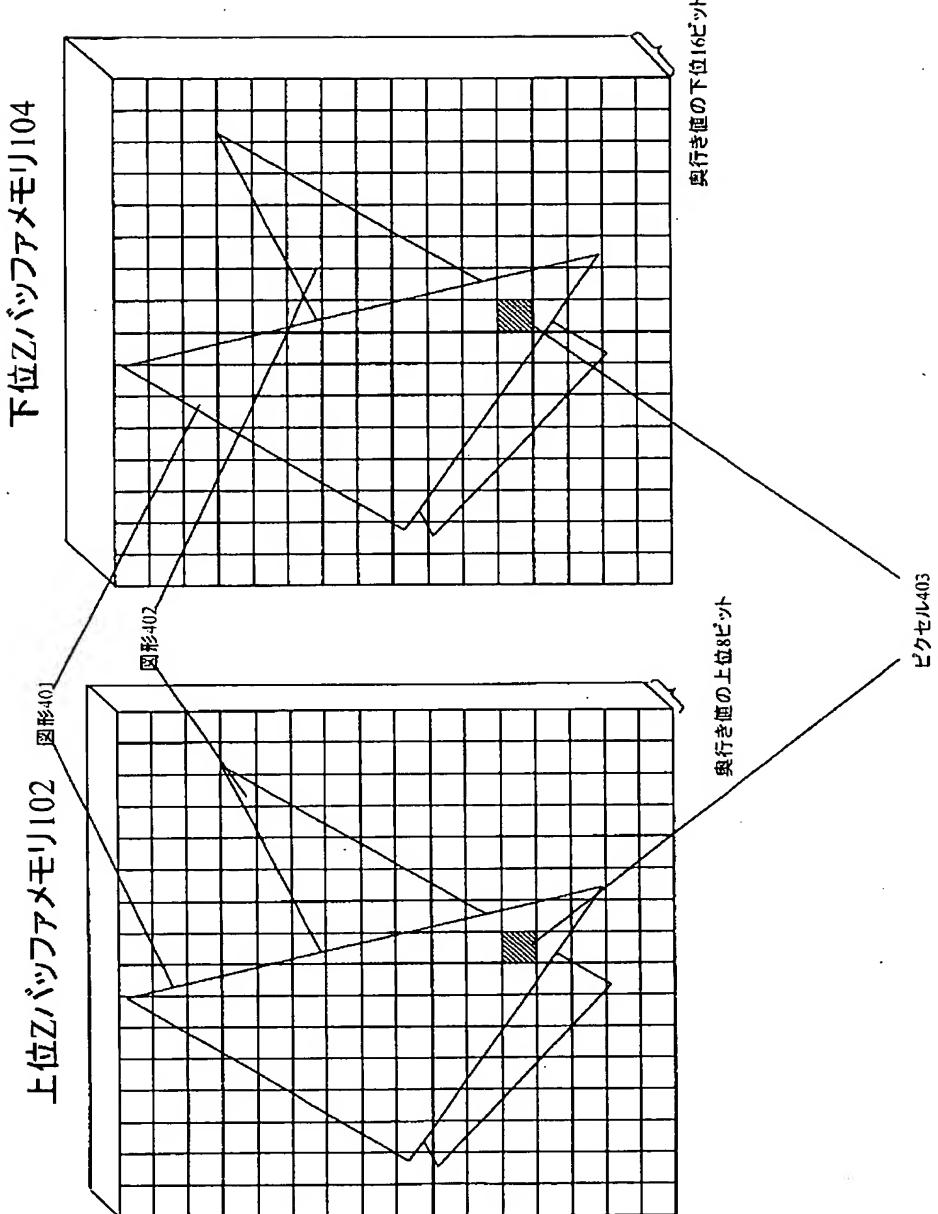
【図 2】



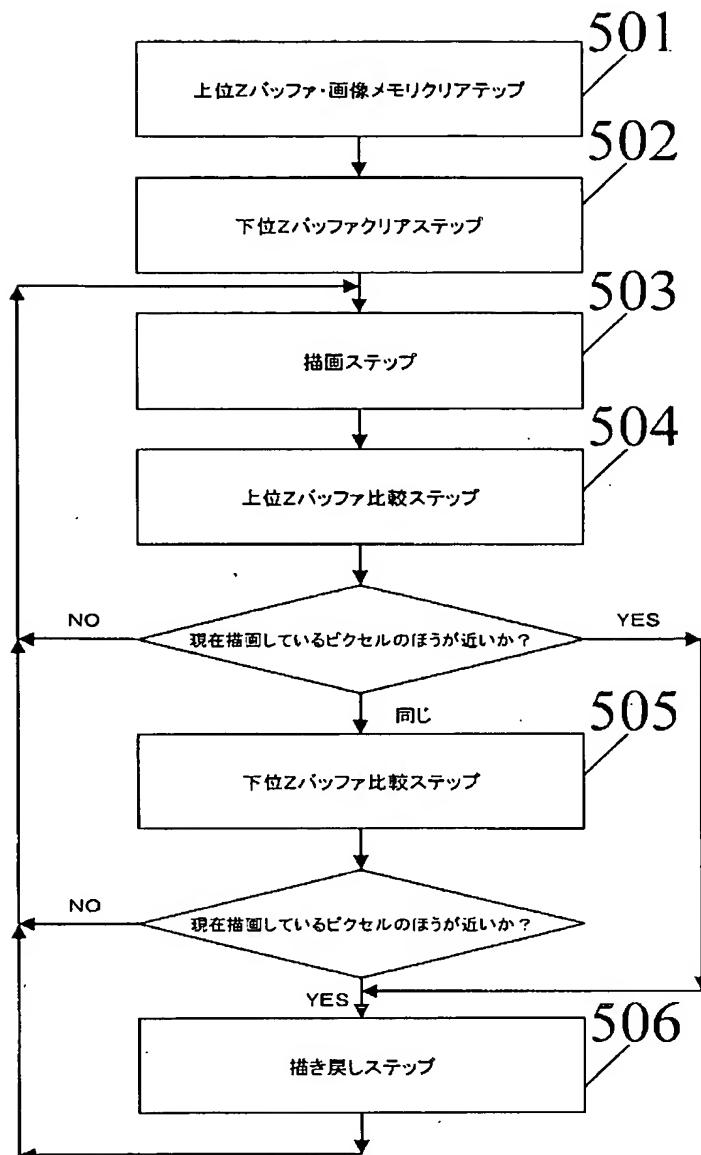
【図3】



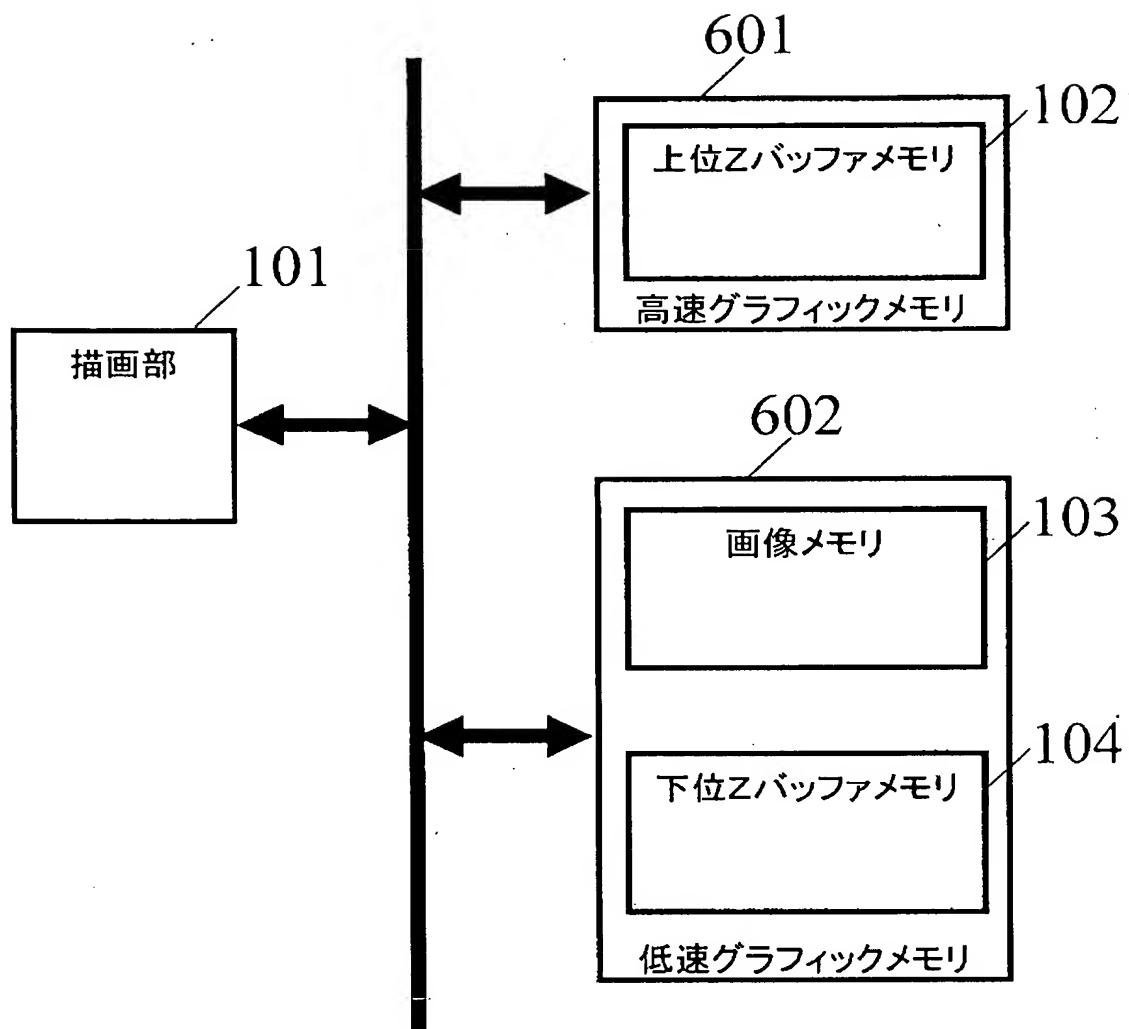
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】限られたバスバンド能力で高精細な3Dグラフィックス映像を作成することが難しい。

【解決手段】カメラと物体間の距離を蓄積するZバッファを、精度の荒いZバッファと、精度の細かいZバッファとに分離することで、距離の遠いもの同士の比較を精度の荒いZバッファで比較し、その荒い精度のZバッファでは判定できないものののみ細かい精度のZバッファで比較することにより、少ないバスバンド幅で隠れ面除去を行うことが出来る。

【選択図】図1

出願人履歴

000005821

19900828

新規登録

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社